

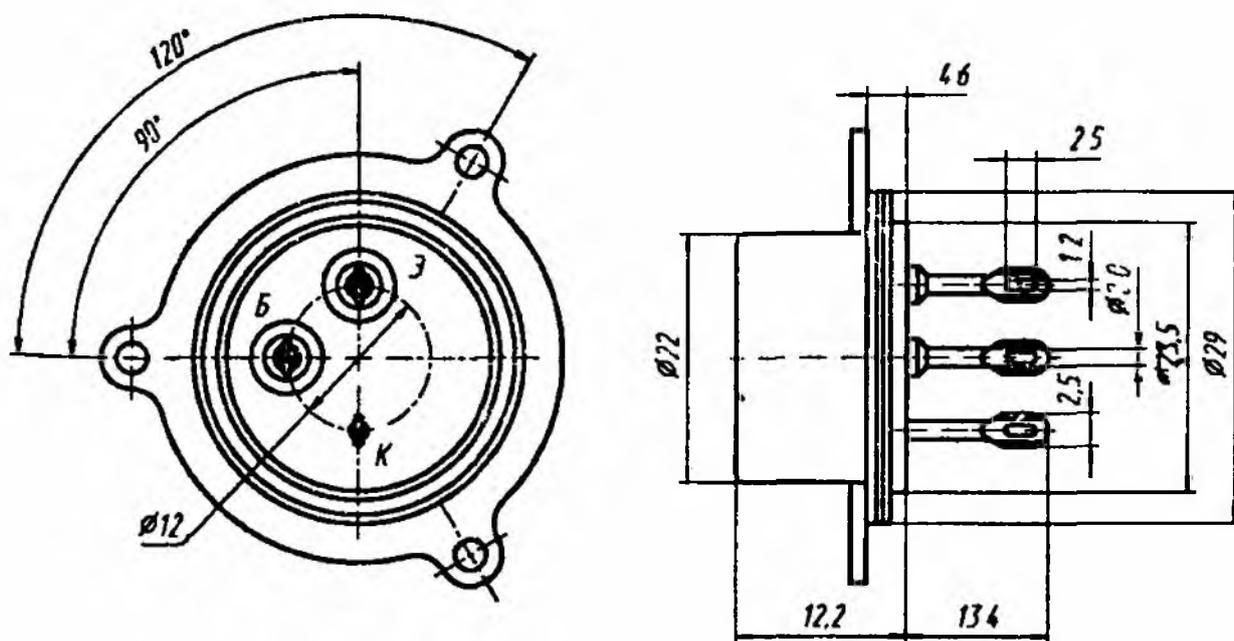
1Т813А, 1Т813Б, 1Т813В

Транзисторы германиевые диффузионно-сплавные структуры $p-n-p$ переключательные. Предназначены для применения в переключающих устройствах. Корпус металлический со стеклянными изоляторами и жесткими выводами.

Масса транзистора не более 28 г.

Изготовитель — акционерное общество «Кремний», г. Брянск.

1Т813(А-В)



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ (на границе насыщения)

при $I_k = 20$ А:

$T = +25$ °С	10...60
$T = +70$ °С, $I_k = 10$ А	10...60
$T = -60$ °С	10...120

Граничное напряжение при $I_3 = 3$ А, $t_{и} \leq 50$ мкс, $f = 20...50$ Гц, не менее:

1Т813А	60 В
1Т813Б	75 В
1Т813В	80 В

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер

при $I_k = 30$ А, $I_б = 3$ А, не более

Напряжение насыщения база—эмиттер

при $I_k = 30$ А, $I_б = 3$ А, не более

Время выключения при $U_{кэ} = 30$ В, $I_k = 30$ А,

$I_b = 5 \text{ А, не более:}$	
1Т813А	3 мкс
1Т813Б, 1Т813В	5 мкс
Обратный ток коллектор—эмиттер	
при $U_{бэ} = 1 \text{ В, не более:}$	
$T = +25 \text{ и } -60 \text{ }^\circ\text{С, } U_{кэ} = 100 \text{ В для 1Т813А,}$	
$U_{кэ} = 125 \text{ В для 1Т813Б, } U_{кэ} = 150 \text{ В}$	
для 1Т813В	16 мА
$T = +70 \text{ }^\circ\text{С, } U_{кэ} = 80 \text{ В для 1Т813А,}$	
$U_{кэ} = 100 \text{ В для 1Т813Б, } U_{кэ} = 120 \text{ В}$	
для 1Т813В	25 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{бэ} = 2 \text{ В,}$	
не более	40 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер	
при $U_{бэ} = 1 \text{ В:}$	
$T = -60...+30 \text{ }^\circ\text{С:}$	
1Т813А	100 В
1Т813Б	125 В
1Т813В	150 В
$T = -60...+70 \text{ }^\circ\text{С:}$	
1Т813А	80 В
1Т813Б	100 В
1Т813В	120 В
Постоянное напряжение база—эмиттер	
при $T = -60...+85 \text{ }^\circ\text{С}$	2 В
Импульсное напряжение база—эмиттер	
при $T = -60...+85 \text{ }^\circ\text{С:}$	
$t_{и} \leq 1 \text{ мс, } Q \geq 2$	4 В
$t_{и} \leq 5 \text{ мкс, } Q \geq 3$	6 В
Постоянный ток коллектора	
при $T_k = -60...+85 \text{ }^\circ\text{С}$	30 А
Импульсный ток коллектора при $t_{и} \leq 1 \text{ мс,}$	
$Q \geq 2, T_k = -60...+85 \text{ }^\circ\text{С}$	40 А
Постоянный ток базы при $T_k = -60...+85 \text{ }^\circ\text{С} ...$	5 А
Импульсный ток базы при $t_{и} \leq 1 \text{ мс, } Q \geq 2,$	
$T_k = -60...+85 \text{ }^\circ\text{С}$	10 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллек-	
тора при $T_k = -60...+25 \text{ }^\circ\text{С:}$	
с теплоотводом	50 Вт
без теплоотвода	1,5 Вт

Температура *p-n* перехода +85 °С
Температура окружающей среды $-60...T_K =$
= +70 °С

Не допускается отключение базы при наличии напряжения между коллектором и эмиттером. Запрещается использовать транзистор в схемах, у которых цепь базы разомкнута по постоянному току.

При $U_{кэ} \geq 20$ В и $R_{бэ} \geq 5$ Ом рекомендуется закрывать транзистор положительным смещением $0,5$ В $\leq U_{бэ} \leq 2$ В.